

# 低価格高精度の JFET入力オペアンプ

# ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4

#### 特長

高速スルーレート: 20V/µs 高速セトリング時間

低いオフセット電圧:1.70mV (max)

バイアス電流:40pA (max) ±4~±18Vの電源動作 低い電圧ノイズ:16nV/√Hz ユニティ・ゲイン安定性 +V<sub>s</sub>を含む同相電圧 広い帯域幅:5MHz

#### アプリケーション

リファレンス・ゲイン/バッファ レベル・シフト/ドライブ アクティブ・フィルタ 電源ラインの監視/制御 電流/電圧の検出または監視 データ・アクイジション サンプル&ホールド回路 積分器

#### 概要

ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4は、バイアス電流がきわ めて低い、低消費電力、高精度のJFET入力オペアンプです。 高い入力インピーダンス、低い入力バイアス電流、広い帯域幅、 高速スルーレート、高速セトリング時間を持っているため、 A/D変換入力の駆動やA/Dコンバータ出力のバッファに最適で す。入力同相電圧には正電源が含まれており、ハイサイドのシ グナル・コンディショニングに最適です。

ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4のその他のアプリケー ションには、電子計測器、ATEの増幅、バッファリング、積分 器回路、計装器品質のフォトダイオード増幅、高速高精度フィ ルタ (PLLフィルタを含む) があります。これらのオペアンプ には、リファレンス・バッファ、レベル・シフト、制御用I/O インターフェース、電源制御、モニタリング機能などのユー ティリティ機能も備わっています。

#### ピン配置

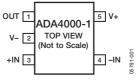


図1. 5ピンTSOT (UJ-5)

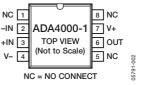


図2. 8ピンSOIC (R-8)

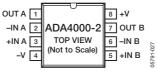


図3. 8ピンSOIC (R-8)

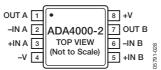


図4. 8ピンMSOP (RM-8)

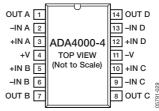


図5. 14ピンSOIC (R-14)

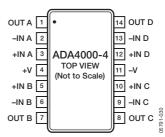


図6. 14ピンTSSOP (RU-14)

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の 利用に関して、あるいは利用によって生じる論と者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は、予告なく変更される場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有 に属します。

- トはREVISIONが古い場合があります。最新の内容については、英語版をご参照ください。 © 2007 Analog Devices, Inc. All rights reserved.

REV. 0

本 社/ 〒105-6891 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワービル 電話03 (5402) 8200

大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪MTビル2号 電話06(6350)6868

## 目次

特長	電源シーケンシング	
アプリケーション1		
概要1		
ピン配置1	アプリケーション	10
改訂履歴2		
仕様3	容量負荷の駆動	10
電気的特性3	セトリング時間	11
絶対最大定格5	外形寸法	12
数抵抗 5	オーダー・ガイド	14

### 改訂履歴

5/07—Revision 0: Initial Version

\_2\_ REV. 0

# 仕様

### 電気的特性

特に指定のない限り、 $V_s$ =±15.0V、 $V_{CM}$ = $V_s$ /2V、 $T_A$ =25°C。

#### 表1

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
INPUT CHARACTERISTICS						
Offset Voltage	$V_{os}$			0.2	1.70	mV
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C			3.0	mV
Input Bias Current	$I_{\mathrm{B}}$			5	40	pA
		$-40^{\circ}\text{C} \le \text{T}_{\text{A}} \le +85^{\circ}\text{C}$			170	pA
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C			4.5	nA
Input Offset Current	$I_{OS}$			2	40	pA
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +85$ °C			80	pA
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C			500	pA
Input Voltage Range	IVR		-11		+15	V
Common-Mode Rejection Ratio	CMRR	$-11 \text{ V} \le \text{V}_{\text{CM}} \le +15 \text{ V}$	80	100		dB
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C		100		dB
Open-Loop Gain	$A_{VO}$	$R_L = 2 k\Omega$ , $V_O = \pm 10 V$	100	110		dB
Offset Voltage Drift	$\Delta V_{OS}/\Delta T$	$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C		2		μV/°C
OUTPUT CHARACTERISTICS						
Output Voltage High	$V_{OH}$	$R_L = 2 k\Omega$ to ground	13.60	13.90		V
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C	13.40			V
Output Voltage Low	$V_{ m OL}$	$R_L = 2 k\Omega$ to ground		-13.4	-13.0	V
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C			-12.80	V
Short-Circuit Current	$I_{SC}$			±28		mA
POWER SUPPLY						
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	$V_S = \pm 4.0 \text{ V to } \pm 18.0 \text{ V}$	82	92		dB
Supply Current/Amplifier	$I_{SY}$			1.35	1.65	mA
		$-40$ °C $\leq$ T <sub>A</sub> $\leq$ +125°C			1.80	mA
DYNAMIC PERFORMANCE						
Slew Rate	SR	$V_{I} = 10 \text{ V}, R_{L} = 2 \text{ k}\Omega$		20		V/µs
Gain Bandwidth Product	GBP			5		MHz
Phase Margin	$\Phi_{ m M}$			60		Degrees
NOISE PERFORMANCE						
Voltage Noise	$e_{n p-p}$	0.1 Hz to 10 Hz		1		μV p-p
Voltage Noise Density	e <sub>n</sub>	f = 1  kHz		16		nV/√Hz
Current Noise Density	i <sub>n</sub>	f = 1  kHz		0.01		pA/√Hz
	-n			0.01		P. Z. IIIZ
INPUT IMPEDANCE	(BIIC)			10114		COllet
Differential Mode	$(R  C)_{IN-DIFF}$			10  4		GΩ  pF
Common Mode	$(R  C)_{INCM}$			$10^3    5.5$		$G\Omega    pF$

REV. 0 — 3 —

特に指定のない限り、 $V_S$ = $\pm 5V$ 、 $V_{CM}$ = $V_S$ /2V、 $T_A$ =25 $^{\circ}$  $^{\circ}$ 。

### 表2

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
INPUT CHARACTERISTICS						
Offset Voltage	$V_{OS}$			0.20	1.70	mV
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C			3.0	mV
Input Bias Current	$I_{\mathrm{B}}$			5	40	pA
		$-40^{\circ}$ C $\leq$ T <sub>A</sub> $\leq$ +85 $^{\circ}$ C			170	pA
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C			3	nA
Input Offset Current	$I_{OS}$			2	40	pA
		$-40^{\circ}\text{C} \le \text{T}_{\text{A}} \le +85^{\circ}\text{C}$			80	pA
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C			500	pA
Input Voltage Range	IVR		-1.5		+5.0	V
Common-Mode Rejection Ratio	CMRR	$-1.5 \text{ V} \le \text{V}_{\text{CM}} \le +3.5 \text{ V}$	72	80		dB
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C		80		dB
Open-Loop Gain	$A_{VO}$	$R_L = 2 \text{ k}\Omega, V_O = \pm 2.5 \text{ V}$	106	114		dB
Offset Voltage Drift	$\Delta V_{OS}/\Delta T$	$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C		2		μV/°C
OUTPUT CHARACTERISTICS						
Output Voltage High	$V_{OH}$	$R_L = 2 \text{ k}\Omega$ to ground	4.0	4.20		V
		$-40^{\circ}$ C $\leq$ T <sub>A</sub> $\leq$ +125 $^{\circ}$ C	3.80			V
Output Voltage Low	$V_{OL}$	$R_L = 2 \text{ k}\Omega$ to ground		-3.45	-3.20	V
		$-40^{\circ}$ C $\leq$ T <sub>A</sub> $\leq$ $+125^{\circ}$ C			-3.00	V
Short-Circuit Current	${ m I}_{ m SC}$			±28		mA
POWER SUPPLY						
Supply Current/Amplifier	$I_{SY}$			1.25	1.65	mA
		$-40$ °C $\leq T_A \leq +125$ °C			1.80	mA
DYNAMIC PERFORMANCE						
Slew Rate	SR	$VI = 10 \text{ V}, R_L = 2 \text{ k}\Omega$		20		V/µs
Gain Bandwidth Product	GBP			5		MHz
Phase Margin	$\Phi_{ ext{M}}$			55		Degrees
NOISE PERFORMANCE						
Voltage Noise	$e_{n p-p}$	0.1 Hz to 10 Hz		1		μV p-p
Voltage Noise Density	$e_n$	f = 1  kHz		16		nV/√Hz
Current Noise Density	$i_n$	f = 1  kHz		0.01		pA/√Hz
INPUT IMPEDANCE						
Differential Mode	$(R  C)_{IN-DIFF}$			10  4		GΩ  pF
Common Mode	$(R  C)_{INCM}$			$10^3    5.5$		GΩ  pF

## 絶対最大定格

#### 表3

Parameter	Rating
Supply Voltage	±18 V
Input Voltage	±V supply
Differential Input Voltage	±V supply
Output Short-Circuit Duration to GND	Indefinite
Storage Temperature Range	−65°C to +150°C
Operating Temperature Range	-40°C to +125°C
Junction Temperature Range	−65°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec)	300°C

上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えると、デバイスに 恒久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定 格のみを指定するものであり、この仕様の動作セクションに記 載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありませ ん。デバイスを長時間絶対最大定格状態に置くと、デバイスの 信頼性に影響を与えることがあります。

#### 熱抵抗

 $\theta_{JA}$ は最悪の条件、すなわち回路ボードに表面実装パッケージを ハンダ付けした状態で規定しています。

#### 表4. 熱抵抗

Package Type	$\theta_{JA}$	$\theta_{JC}$	Unit
5-Lead TSOT (UJ-5)	172.92	61.76	°C/W
8-Lead SOIC (R-8)	112.38	61.6	°C/W
8-Lead MSOP (RM-8)	141.9	43.7	°C/W
14-Lead SOIC (R-14)	88.2	56.3	°C/W
14-Lead TSSOP (RU-14)	114	23.3	°C/W

#### 電源シーケンシング

入力信号の受信と同時かその前に、オペアンプの電源電圧を設定する必要があります。これが不可能な場合は、入力電流を10mAに制限する必要があります。

#### ESDに関する注意



ESD (静電放電) の影響を受けやすいデバイスです。電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されないまま放電することがあります。本製品は当社独自の特許技術であるESD保護回路を内蔵してはいますが、デバイスが高エネルギーの静電放電を被った場合、損傷を生じる可能性があります。したがって、性能劣化や機能低下を防止するため、ESDに対する適切な予防措置を講じることをお勧めします。

REV. 0 — 5 —

## 代表的な性能特性

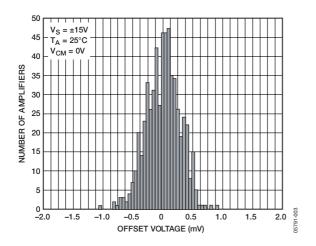


図7. 入力オフセット電圧の分布  $(V_S=\pm 15V)$ 

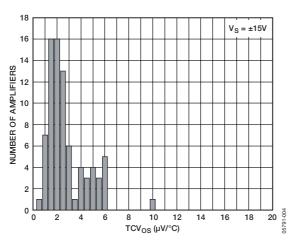


図8. オフセット電圧ドリフトの分布  $(V_S=\pm 15V)$ 

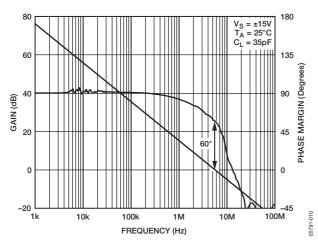


図9. オープンループ・ゲインと位相マージンの 周波数特性  $(V_S = \pm 15V)$ 

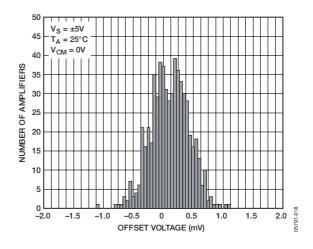


図10. 入力オフセット電圧の分布  $(V_S = \pm 5V)$ 

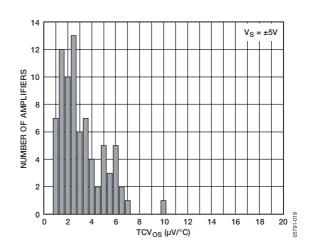


図11. オフセット電圧ドリフトの分布  $(V_S = \pm 5V)$ 

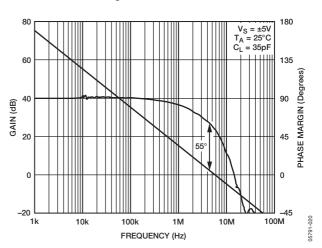


図12. オープンループ・ゲインと位相マージンの 温度特性  $(V_S = \pm 5V)$ 

─6 ─ REV. 0

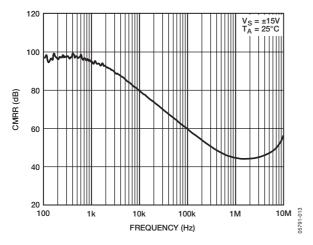


図13. 同相ノイズ除去比の周波数特性  $(V_S = \pm 15V)$ 

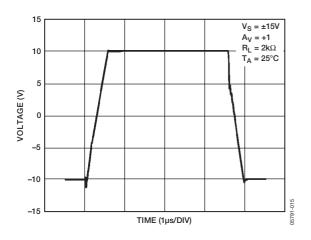


図14. 大信号過渡応答(V<sub>S</sub>=±15V)

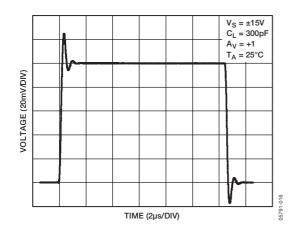


図15. 小信号過渡応答(V<sub>S</sub>=±15V)

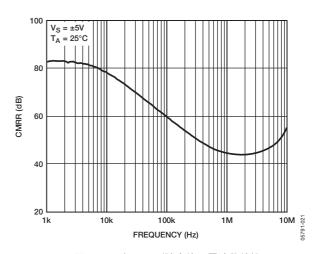


図16. 同相ノイズ除去比の周波数特性  $(V_S = \pm 5V)$ 

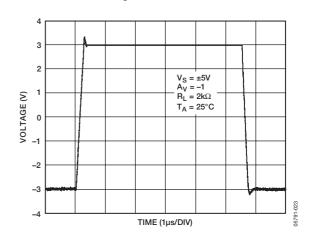


図17. 大信号過渡応答(V<sub>S</sub>=±5V)

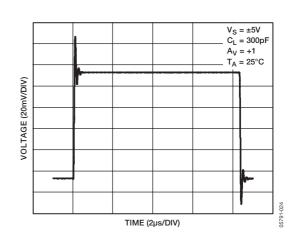


図18. 小信号過渡応答(V<sub>S</sub>=±5V)

REV. 0 — 7 —

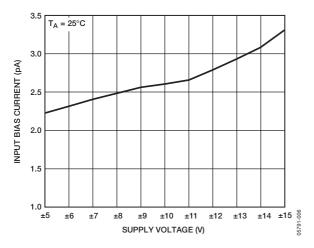


図19. 電源電圧 対 入力バイアス電流

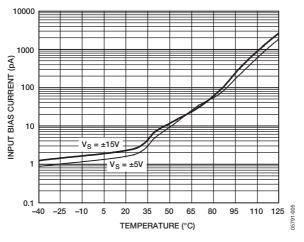


図20. 入力バイアス電流の温度特性

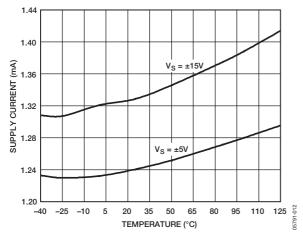


図21. 電源電流の温度特性

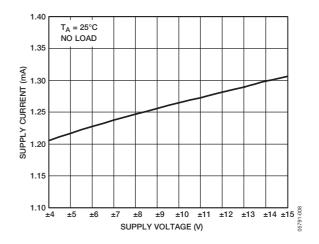


図22. 電源電圧 対 電源電流

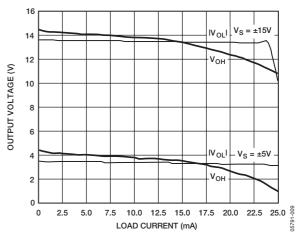


図23. 負荷電流 対 出力電圧

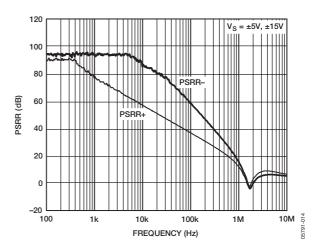


図24. PSRRの周波数特性

─8 ─ REV. 0

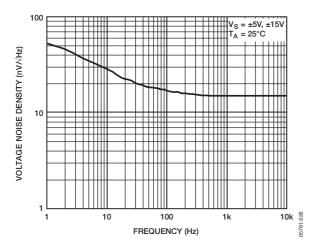
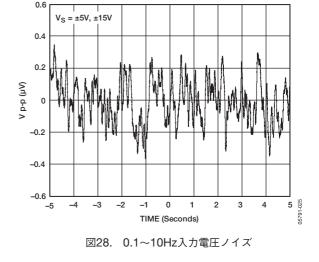


図25. 電圧ノイズ密度の周波数特性



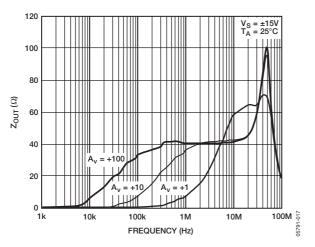


図26. 出力インピーダンスの周波数特性

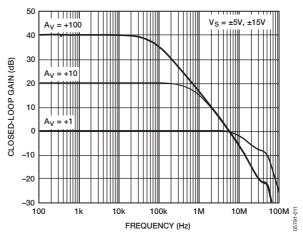


図29. クローズドループ・ゲインの周波数特性

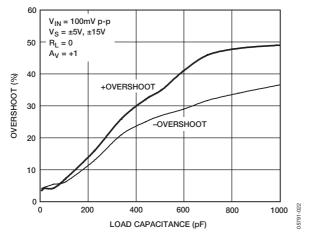


図27. 負荷容量 対 オーバーシュート

REV. 0 — 9 —

## アプリケーション

#### 出力の位相反転と入力ノイズ

位相反転とは、アンプの伝達関数の極性が変化することです。 アンプの入力に入力された電圧が最大同相電圧を超えると、位 相反転が発生することがあります。アンプのゲインを1に設定 すると、位相が反転します。

大部分のJFETアンプは、入力が同相入力を超えると入力信号の位相を反転します。位相反転は、ADA4000-xファミリーの一時的な動作です。同相電圧に戻ることによって、正常な動作に復帰します。この現象は入力段の飽和に起因しており、これによってドレイン/ゲート間のダイオードが順方向にバイアスされます。非反転アプリケーションでは、アンプの入力信号と非反転端子の間に1本の直列抵抗を挿入するだけで簡単にこの問題を解決できます。この抵抗の追加によってアンプのトータル入力ノイズが増えるため、抵抗の値はアプリケーションによって異なります。回路のトータル・ノイズ密度は、次の式から得られます。

$$e_{nTOTAL} = \sqrt{e_n^2 + (i_n R_s)^2 + 4kTR_s}$$

ここで、

 $e_n$ は、アンプの入力電圧ノイズ密度です。  $i_n$ は、アンプの入力電流ノイズ密度です。  $R_S$ は、非反転端子に接続した信号源抵抗の値です。 kは、ボルツマン定数( $1.38\times 10^{-23}$  J/K)です。 Tは、ケルビン単位の周囲温度です( $T=273+\mathbb{C}$ )。

一般に、大きな電流がアンプに流入しないように入力電流を 5mA未満に制限することが行われています。

#### 容量負荷の駆動

ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4は、反転構成でも非反転 構成でも、すべてのゲインで安定しています。これらのアンプ は1000pFの容量負荷を駆動できますが、ユニティ・ゲインの 設定が変動することはありません。

ただし、大部分のアンプと同様に、ユニティ・ゲインの設定で 比較的大きい容量負荷を駆動する場合は、過度のオーバー シュートとリンギングが生じることがあります。スナバ・ネッ トワークを使用すると、この問題を簡単に解決できます(図30 を参照)。

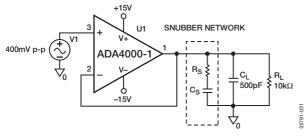


図30. スナバ・ネットワークの構成

この補償方法は、 $R_s$ が帰還ネットワークの外部にあるため出力の振幅が小さくならず、ゲイン精度が変化しない点で優れています。回路の容量負荷に応じて $R_s$ と $C_s$ の値が変化するため、最適な値は経験的に決めることができます。図31のオシロスコープ画像は、400mVのパルスに応答するADA4000-xファミリーの出力です。この回路はユニティ・ゲインの設定で、容量負荷として500pFと10k $\Omega$ を並列に接続しています。

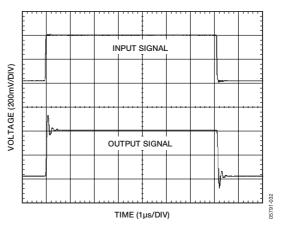


図31. スナバ・ネットワークを使用しない場合の容量負荷の 駆動

スナバ回路を使用すると、同じ容量負荷でオーバーシュートが30%から6%に削減します。図32に示すように、リンギングはほぼなくなります。この回路では $R_s$ が $41\Omega$ 、 $C_s$ が10nFです。

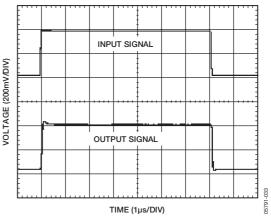


図32. スナバ・ネットワークを使用する場合の容量負荷

— 10 — REV. 0

### セトリング時間

セトリング時間とは、アンプの出力が最終値の一定の割合に達し、そこに落ち着くまでの所要時間です。データ・アクイジション・システムで重要なパラメータとなります。大部分のバイポーラDACコンバータは電流出力であるため、電流を電圧に変換するために外部オペアンプが必要です。このため、アンプのセトリング時間は出力信号の全セトリング時間に影響します。全セトリング時間の近似値は、次の式で求めることができます。

 $t_s Total = \sqrt{(t_s DAC)^2 + (t_s AMP)^2}$ 

ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4は、 $1.2\mu$ s未満でその最終値の0.1%以内にセトリングします。図34の構成回路を使用して、セトリング時間のテストを実施しています。

図33のセトリング時間の測定では、入力信号は10V、出力は誤差信号です。

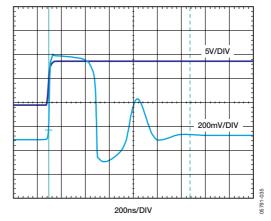


図33. 疑似加算ノード法を用いたセトリング時間の測定

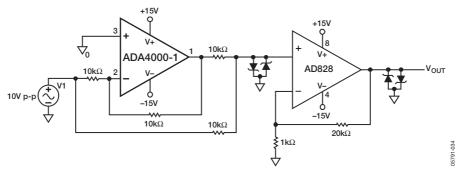
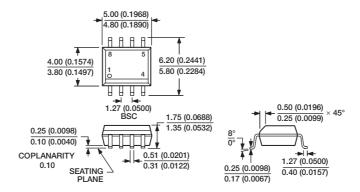


図34. セトリング時間のテスト回路

REV. 0 — 11 —

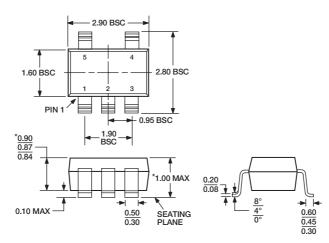
## 外形寸法



COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012-AA
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.

図35. 8ピン標準スモール・アウトライン・パッケージ [SOIC\_N] ナロー・ボディ

> (R-8) 寸法単位:mm(インチ)

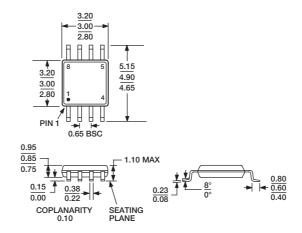


\*COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-193-AB WITH THE EXCEPTION OF PACKAGE HEIGHT AND THICKNESS.

図36. 5ピン薄型スモール・アウトライン・トランジスタ・パッケージ [TSOT] (UJ-5)

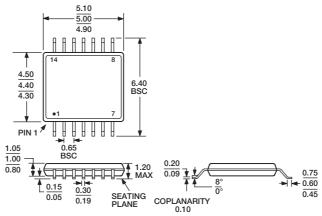
寸法単位:mm

- 12 -- REV. 0



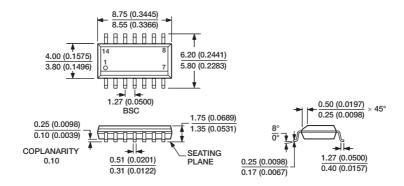
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-AA

図37. 8ピン・ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ [MSOP] (RM-8) 寸法単位:mm



COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-153-AB-1

図38. 14ピン標準スモール・アウトライン・パッケージ [TSSOP] (RU-14) 寸法単位:mm



COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012-AB
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.

図39. 14ピン標準スモール・アウトライン・パッケージ [SOIC\_N] (R-14) 寸法単位:mm(インチ)

REV. 0 — 13 —

## オーダー・ガイド

Model	Temperature Range	Package Description	Package Option	Branding
ADA4000-1ARZ <sup>1</sup>	-40°C to +125°C	8-Lead SOIC_N	R-8	
ADA4000-1ARZ-R71	-40°C to +125°C	8-Lead SOIC_N	R-8	
ADA4000-1ARZ-RL <sup>1</sup>	-40°C to +125°C	8-Lead SOIC_N	R-8	
ADA4000-1AUJZ-R21	-40°C to +125°C	5-Lead TSOT	UJ-5	A14
ADA4000-1AUJZ-R7 <sup>1</sup>	-40°C to +125°C	5-Lead TSOT	UJ-5	A14
ADA4000-1AUJZ-RL <sup>1</sup>	-40°C to +125°C	5-Lead TSOT	UJ-5	A14
ADA4000-2ARZ <sup>1</sup>	-40°C to +125°C	8-Lead SOIC_N	R-8	
ADA4000-2ARZ-R71	-40°C to +125°C	8-Lead SOIC_N	R-8	
ADA4000-2ARZ-RL <sup>1</sup>	-40°C to +125°C	8-Lead SOIC_N	R-8	
ADA4000-2ARMZ-R21	-40°C to +125°C	8-Lead MSOP	RM-8	A1H
ADA4000-2ARMZ-RL <sup>1</sup>	−40°C to +125°C	8-Lead MSOP	RM-8	A1H
ADA4000-4ARZ <sup>1</sup>	-40°C to +125°C	14-Lead SOIC_N	R-14	
ADA4000-4ARZ-R71	-40°C to +125°C	14-Lead SOIC_N	R-14	
ADA4000-4ARZ-RL <sup>1</sup>	-40°C to +125°C	14-Lead SOIC_N	R-14	
ADA4000-4ARUZ <sup>1</sup>	-40°C to +125°C	14-Lead TSSOP	RU-14	
ADA4000-4ARUZ-RL <sup>1</sup>	-40°C to +125°C	14-Lead TSSOP	RU-14	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z=RoHS準拠製品